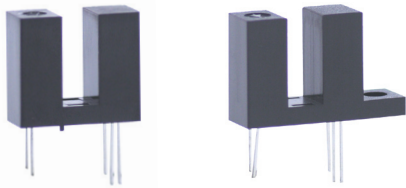


KI1315,1320

透過型フォトセンサ 防塵タイプ



Photo Interrupter - Dust proof type



概要 Description

KI1315,1320 は、外側にケースカバー、内側に検出用スリットを持つ2重構造の防塵型、フォトIC出力の透過型フォトセンサです。

Model KI1315/1320 consist of an Infra Red LED and a Photo IC(Digital Output). Outer package has no aperture on the both light pass surfaces of the emitter and detector.

特長 Feature

- アンプ内蔵、オープンコレクタ出力
- 防塵構造：粉塵の影響を受けにくい
- 検出精度が高い：内蔵スリット幅 0.5mm
- 検出溝が深い：12mm
- その他シリーズ
フォトトランジスタタイプ・・・KI1319, 1324

- Built-in amplifier, Open collector output type.
- Easy removing paper dust.
- High-resolution : slit width 0.5mm.
- Slot depth-12mm.
- The other model; Phototransistor type ... KI1319, KI1324

用途 Application

- カード機器、両替機の物体通過検出
- 自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
- OA機器、その他
- Object passing for Card reader, Bill exchanger.
- Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
- Paper detection for O.A. equipment.

最大定格 Absolute Maximum Ratings [Ta=25°C **]

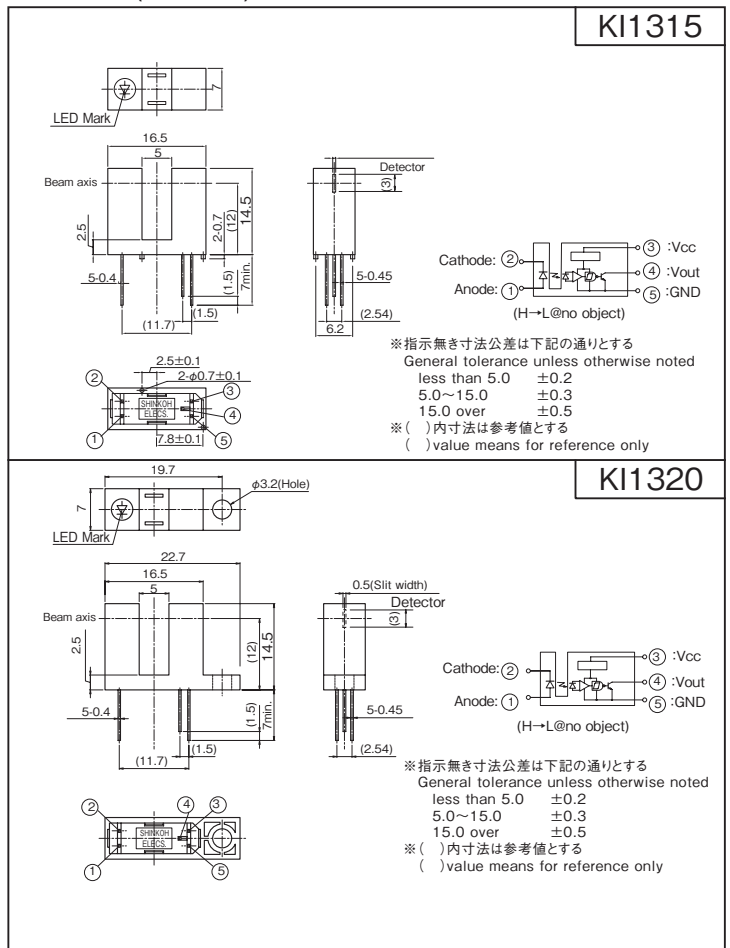
Item		Symbol	Rating	Units
発光側 Emitter	順電流 Forward Current	IF	50	mA
	パルス順電流 Pulse Forward Current ※1	IFP	1	A
	逆電圧 Reverse Voltage	VR	5	V
受光側 Detector	電源電圧 Supply Voltage	VCC	17	V
	出力電流 Output Current	IoL	16	mA
	許容損失 Power Dissipation	PC	175	mW
	動作温度 Operating Temperature	Topr	-20 ~ +75	°C
保存温度 Storage Temperature	Tstg	-30 ~ +85	°C	
半田付温度 Soldering Temperature ※2	Tsol	260	°C	

電気的光学的特性 Electro-Optical Characteristics [Ta=25°C **]

Item		Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Units
発光側 Emitter	順電圧 Forward Voltage	VF	IF=20mA	—	1.2	1.5	V
	逆電流 Reverse Current	IR	VR=5V	—	—	10	μA
受光側 Detector	ローレベル出力電圧 Low-Level Output Voltage	VoL	IoL=16mA, IF=15mA	—	0.15	0.4	V
	ハイレベル出力電圧 High-Level Output Voltage	VoH	IF=0	Vcc × 0.9	—	—	V
	ローレベル供給電流 Low-Level Supply Current	ICCL	VCC=5V, IF=15mA	—	—	3.4	mA
	ハイレベル供給電流 High-Level Supply Current	ICCH	VCC=5V, IF=0	—	—	2.2	mA
伝達特性 Coupled	スレッシュホールド入力電流 Threshold Input Current	IFHL	VCC=5V	—	—	10	mA
	ヒステリシス Hysteresis	IFLH/IFHL	VCC=5V	—	0.65	—	—
	応答時間 Response Time	上昇 Rise Time	tr	VCC=5V, IF=20mA, RL=280 Ω	—	0.1	—
下降 Fall Time		tf	—		0.04	—	

** : Ta=25°C unless otherwise noted

Dimension(Unit:mm)

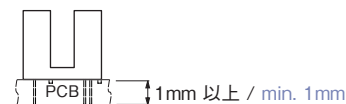


＜ご使用上の注意＞

センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01 μF 以上のバイパスコンデンサを付けて使用されることを推奨致します。

＜Operation Notice＞

We recommend to use with min. 0.01 μF of bypass capacitor between Vcc and GND and nearby of sensor.



半田領域
Solder Area

- ※1. パルス幅 $t_w \leq 100 \mu \text{sec}$ Duty比=0.01
- ※2. パッケージ底面より 1mm 以上の位置で 5 秒間 (上図参照)
- ※1. Pulse width $t_w \leq 100 \mu \text{sec}$ Duty ratio=0.01
- ※2. Soldering condition 5sec. at 1mm over from body.

KI1315/1320

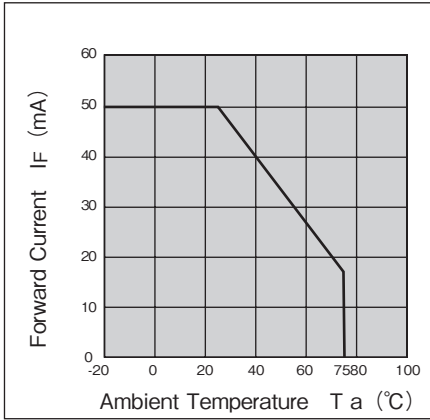
定格・特性曲線

Characteristics

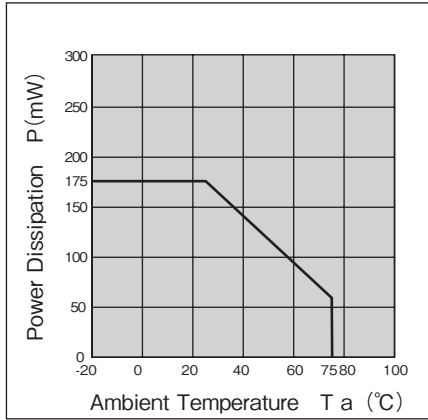
※注意 最大絶対定格を超えないようにご使用ください

Note: Operation never exceeds each value of Absolute Maximum Ratings.

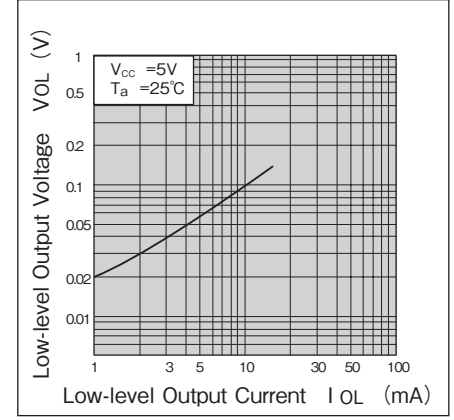
順電流低減曲線



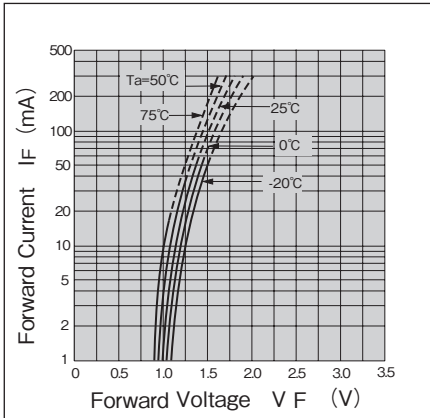
許容損失低減曲線



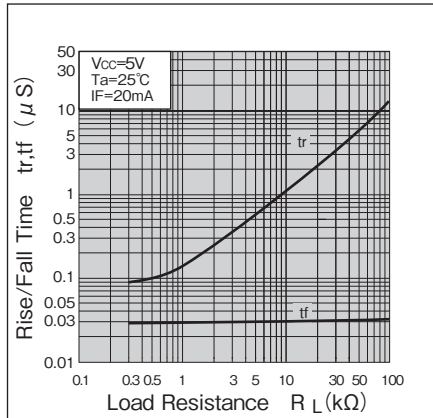
ローレベル出力電圧—
ローレベル出力電流特性 (代表例)



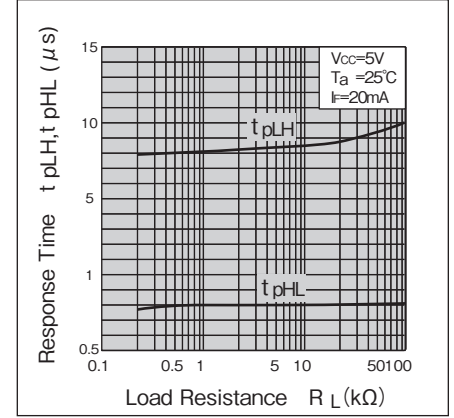
順電流—順電圧特性 (代表例)



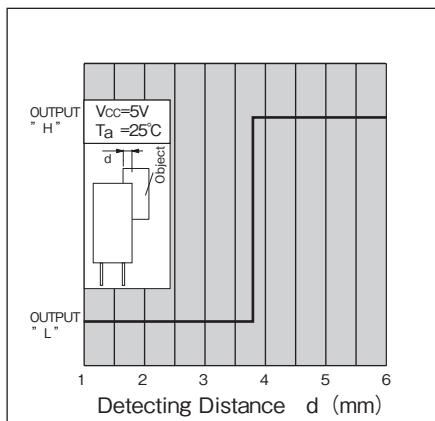
上昇、降下時間—
負荷抵抗特性 (代表例)



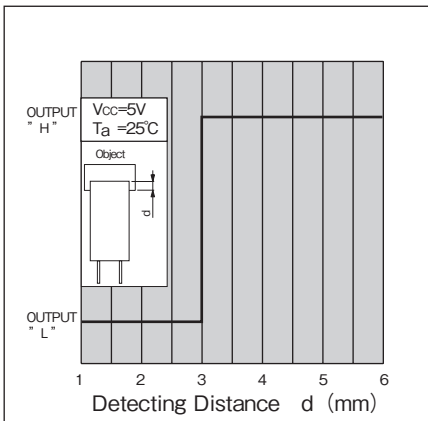
伝搬時間—負荷抵抗特性 (代表例)



検出位置特性1 (代表例)



検出位置特性2 (代表例)



・カスタムも承ります。お気軽にお問合せください。 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

・ A Custom designed package is available on request. ・ Specification are subject to change without notice.